## Zeeman効果を利用したプラズマ局所計測法

磁場強度が大きく、かつ観測視線方向に磁場強度が勾配を持つような条件下で適用可能な手法。 受動的な分光計測から、プラズマの局所計測を行うことが可能。



周辺領域に加え、炉心領域へ本手法を適用することにより、対象とする発光の 発光位置を決定し、また、発光位置における温度や流れ速度の局所値を計測する。

## Zeeman効果の評価

外部磁場中での軌道電子ハミルトニアン

$$H = \sum_{i} \{ \frac{1}{2m_e} [p_i - \frac{e}{c} A(r_i)]^2 + \phi(r_i) \} + \varsigma L \cdot S + \frac{e}{2m_e} B \cdot (L + 2S)$$

 $H_{LS}$ : (スピン・軌道相互作用)  $H_B$ : (外部磁場との相互作用)

H<sub>LS</sub>とH<sub>B</sub>を摂動項として取り扱

 $\Delta E = g_L \mu_B M |B| \qquad (\mathbf{H}_{LS} >> \mathbf{H}_B) \ \mathbf{g} \mathbf{\ddot{r}} (\mathbf{I} \mathbf{\ddot{r}}) \text{Zeeman} \mathbf{\dot{m}}$  $\Delta E = \mu_B (M_L + 2M_S) |B| \quad (\mathbf{H}_B >> \mathbf{H}_{LS}) \ \text{Paschen-Back} \mathbf{\overline{m}}$  $\mathbf{\overline{m}} \mathbf{\ddot{m}} \mathbf{\ddot{g}} \mathbf{\ddot{n}} \mathbf{c} \mathbf{\ddot{n}} \mathbf{c} \mathbf{\ddot{n}} \mathbf{c} \mathbf{\ddot{n}}$ 

実験条件下(~7T)では、元素によってはこれら二つ 極限状態で近似できないことが予測される。 一般的な取り扱いとしては、行列要  $< J, M | H_B | J', M' > =$ 

 $\sum_{M_L,M_S} (M_L + 2M_S) \mu_B | B | < J, M | M_L, M_S > < M_L, M_S | J', M' >$ 

を数値的に対角化計算し、エネルギーの摂動を求める。

➡ 特にH<sub>LS</sub>~H<sub>B</sub>の場合は、磁場強度の変化に対して非線形な応 (B、B<sup>2</sup>及びそれらの平方根が含まれるため)

L : <b>全軌道角運動量</b>
S :全スピン角運動量
$\mathbf{J}  : (=\mathbf{L} + \mathbf{S})$
M:J の磁場方向成分
M <sub>L</sub> : L の磁場方向成
M <sub>S</sub> : S の磁場方向成分
g <sub>L</sub> :Lande のg因子
µ <sub>B</sub> :Bohr磁子

#### 遷移エネルギーのZeeman分裂



## スペクトル形状の評価

摂動系の波動関数は、非摂動系の波動関数の線形結合として求められる。

$$| \psi_{perturbed} = \sum_{J,M} C_{J,M} | J, M \quad C: 定数$$
  
**この時、Wigner-Eckartの定理を用いて遷移確率が**

$$I \propto n' v^{4} | \psi | r_{q} | \psi' |^{2}$$

$$= n' v^{4} | \sum_{J,M} \sum_{J',M'} C_{J,M}^{*} C_{J',M'} < J || r || J' > \begin{pmatrix} J & 1 & J' \\ -M & q & M' \end{pmatrix} |^{2}$$

$$= n' v^{4} | \sum_{J,M} \sum_{J',M'} C_{J,M}^{*} C_{J',M'} < J || r || J' > \begin{pmatrix} J & 1 & J' \\ -M & q & M' \end{pmatrix} |^{2}$$

$$= n' v^{4} | \sum_{J,M} \sum_{J',M'} C_{J,M}^{*} C_{J',M'} < J || r || J' > \begin{pmatrix} J & 1 & J' \\ -M & q & M' \end{pmatrix} |^{2}$$

$$= n' v^{4} | \sum_{J,M} \sum_{J',M'} C_{J,M}^{*} C_{J',M'} < J || r || J' > \begin{pmatrix} J & 1 & J' \\ -M & q & M' \end{pmatrix} |^{2}$$

$$= n' v^{4} | \sum_{J,M} \sum_{J',M'} C_{J,M}^{*} C_{J',M'} < J || r || J' > \begin{pmatrix} J & 1 & J' \\ -M & q & M' \end{pmatrix} |^{2}$$

$$= n' v^{4} | \sum_{J,M} \sum_{J',M'} C_{J,M}^{*} C_{J',M'} < J || r || J' > \begin{pmatrix} J & 1 & J' \\ -M & q & M' \end{pmatrix} |^{2}$$

$$= n' v^{4} | \sum_{J,M} \sum_{J',M'} C_{J,M}^{*} C_{J',M'} < J || r || J' > \begin{pmatrix} J & 1 & J' \\ -M & q & M' \end{pmatrix} |^{2}$$

$$= n' v^{4} | \sum_{J,M} \sum_{J',M'} C_{J,M'}^{*} < J || r || J' > \begin{pmatrix} J & 1 & J' \\ -M & q & M' \end{pmatrix} |^{2}$$

$$= n' v^{4} | \sum_{J,M} \sum_{J',M'} C_{J,M'}^{*} < J || r || J' > \begin{pmatrix} L & J & S \\ J' & L' & 1 \end{pmatrix} |^{2}$$

$$= n' v^{4} | \sum_{J,M} \sum_{J',M'} C_{J,M'}^{*} < J || r || J' > \begin{pmatrix} L & J & S \\ J' & L' & 1 \end{pmatrix} |^{2}$$

のように計算される。上準位の密度n'に関しては、縮退度2J+1に比例すると仮定。



# 炉心近傍に存在するイオン種への適用

Zeeman効果による波長シフト

Doppler拡がりによるピークの拡がり

 $\Delta \lambda_{Zeeman} \approx \frac{\lambda_0^2}{h_c} \mu_B |B|$  $\Delta \lambda_{Doppler} = 2\sqrt{\ln 2} \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} (\frac{\lambda_0}{c})^2$ これらが等しくなる磁場強度  $|B|=1.65 \times 10^{-6} \times \frac{1}{\lambda_{a}} \sqrt{\frac{T}{A}}$  (T) が、計測の目安 (A:原子) Aが大きな元素を計測することで、必要磁場強度を小さくすることが可能 (C: A=12, O: A=16) イオン化エネルギーをイオン温度とした場合、  $CV (T_i = 392 \text{ eV}) \longrightarrow |B| = 41 \text{ T}$ OV (T\_i = 114 eV)  $\longrightarrow |B| = 15 \text{ T}$ が必要となる磁場強度 直線偏光子を用いて 成分のみ計測すれば、必要磁場強度は半分になる。 CV ( $T_i = 392 \text{ eV}$ )  $\longrightarrow$  |B| = 20.5 TOVイオンが計測対象の候補となる **OV** ( $T_i = 114 \text{ eV}$ )  $\longrightarrow$  |**B**| = 7.5 T ➡ 磁力線ピッチ角が十分に小さいことが必要となる。 直線偏光子 放電条件  $B_T = 6.4T$ ,  $I_p = 70kA$  の場合 ピッチ角 =  $B_p/B_T$  は LCFS付近でも凡そ±0.02°程度であり十分小さい。 炉心では発光位置の間での磁場強度差が小さくなり、 また、多価イオンからの発光では。が小さくなる 炉心では発光が磁気面関数になることを利用し、 フィッティングの際 に複数の発光位置における、温度、密度が等しいとする。

## 超伝導強磁場トカマク TRIAM-1M





九州大学応用力学研究所 炉心理工学研究センター

プラズマ大半径: 840 mm プラズマ小半径: 120 mm (水平方向) × 180 mm (垂直方向) トロイダル磁場強度: < 8T (16-Nb<sub>3</sub>Sn TF coil): 8T (6kA) プラズマ電流: 470kA (Ohmic) 70kA (LHCD: 50kW(2.45GHz), 200kW(8.2GHz)) 放電時間: 500ms (Ohmic), ~5時間 (2.45GHz), ~1分 (8.2GHz)

### TRIAM-1M 25チャネル可視分光計測系



光ファイバ: 25本バンドル型 12m伝送 (コア径 230µm, クラッド径 250µm)
分光器: Acton Research AM-510 (f=1.0m, F/8.7, 1800本回折格子)
ICCD: P.I. ICCD-1024MG-E/1, 1024 × 256 pixel (26µm × 26µm)

#### 周辺領域の中性原子への適用(H 線)



## 水素原子の温度成分



#81382 ECD-mode 8.2GHz LHCD  $B_T = 7.0 \text{ T}, I_p = 40 \text{ kA}, \ < n_e > = 6.0 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ 



- 再結合 H<sup>+</sup>(cold) + e- H<sub>0</sub>(cold): 0.1 ~ 1eV - 分子解離 H<sub>2</sub> + e H + H : ~0.3eV
- 分子解離  $H_2 + e$  H+H:~3eV -  $H_2^+$ からの分子解離  $H_2 + e$   $H_2^+ + 2e$  H+H+2e:~4.3eV  $H_2 + e$   $H_2^+ + 2e$  H+H+2e:~1.5eV

-壁からの反射 H<sup>+</sup> H<sub>0</sub> (reflected): ~50eV - 荷電交換 H<sub>0</sub>(cold) + H<sup>+</sup>(hot) H<sub>0</sub>(hot) + H<sup>+</sup>(cold) : 20 ~ 100eV

単純には、cold 成分 0~1eV warm 成分 1~10eV hot 成分 ~ 50eV の三温度で近似可能。

→ 正確には、中性粒子輸送コード等により 解析する必要がある。



8.2GHz LHCD 放電時のH スペクトル の場合は2温度 (0.8 eV, 10 eV) でフィッティング可能

25本の観測視線で計測したスペクトルに対し、二温度を仮定したフィッティングを行い、 発光位置を求めた。

## 発光位置の分離(周辺領域からの発光)



発光が起こっていることが確認できる。

中性原子であるため、発光領域の軸対称性に関しては、問題が残る

## 炉心方向へ向かうリサイクリングフラックス



# 炉心近傍のイオン種への適用 (OV $2s3s^3S_1-2s3p^3P_1$ 線)



以下のような仮定を置き、フィッティングを行った。

一箇所からの発光スペクトル

・一箇所からの発光を観測したスペクトルから求まる温度を 同一磁気面上の温度として用いる。 ・強磁場側、弱磁場側での発光強度を等しいとする。 ·Dopplerシフトは考慮しない(B<sub>T</sub> が大きいため  $E \times B^{\dagger}$ リフトによる流れv =  $E_r \times B_T / |B_T|^2$  が小さい。) E<sub>r</sub> = 数 kV/m の場合に v ~ 1km/s程度であり、Dopplerシフトは0.00185 nm程度 これに対し、逆線分散は 0.0115 nm/pixel 程度であるため、計測が難しい。

## 発光位置の分離(炉心近傍からの発光)



#### まとめ

Zeeman効果を利用したプラズマ局所計測法をTRIAM-1Mトカマクに適用し、

- 直線偏光子を用いることにより、Zeemanシフトする発光の 成分のみを選択的に 観測することにより、分離精度を向上させた。
- Zeemanシフトしたスペクトルの精密なフィッティングのために、計算コードを作成し、 発光強度を含めた形で、スペクトル形状の厳密な評価を行った。
- H 線及びOV(3<sup>3</sup>S<sub>1</sub>-3<sup>3</sup>P<sub>1</sub>)線に対し、25本の観測視線で計測したスペクトルにフィッティングを 行った結果、以下のように発光位置が求まった。



#### 最外殼磁気面

得られた発光位置は、目安であるAbel逆変換による結果と矛盾しない結果を示していることが 確認でき、本手法を周辺プラズマに加え、炉心領域へも適用可能であることが実証された。

#### 発光位置の決定に関する誤差評価

-発光領域の拡がりによる 成分の裾の拡がりが存在する場合、フィッティング時に誤差を 生じる可能性があるため、発光領域の拡がりを評価する必要がある。

→ 直線偏光子により 成分のみを計測する等すれば、ある程度評価が可能 ( 成分は磁場強度に応じてZeemanシフトしないため)

